

Амирова Сабина Икрам кызы.

Кандидат физико-математических наук.
Преподаватель кафедры Физической электроники.

Рабочий номер: 99412-539-73-73.

E-mail: sbn.amirova@mail.ru



Краткая биография: Родилась 5 ноября 1977 года в городе Баку. Окончив школу №20, получила образование на физическом факультете Бакинского Государственного Университета. Замужем, имеет двоих детей.

Образование, научная степень:

1994-1998 степень бакалавра Физического факультета по специальности «Физическая электроника» БГУ.

1998-2000 степень магистра по специальности «Физика плазмы» Физического факультета БГУ.

В 2008 году - защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Электронные процессы в тонких пленках твердых растворов типа $Cd_{1-x}Zn_xS_{1-y}Se_y$ и структурах на их основе».

Трудовая деятельность:

2000-2004 - старший лаборант на кафедре Физической электроники Физического Факультета БГУ.

С 2004 года - преподаватель на кафедре Физической электроники Физического факультета БГУ.

Преподаваемые дисциплины:

Общая физика, Основы физической электроники, Физика электронных приборов.

Количество научных работ - более 30

Проводимые исследования:

Изучение электронных процессов в тонких пленках твердых растворов полупроводниковых соединений $A^{II}B^{VI}$ и структурах на их основе.

Участие в международных семинарах, симпозиумах и конференциях:

2006, 2007, 2008 -Европейское Общество по Материаловедению, Весенний Семинар, Страсбург, Франция.

2006, 2012, 2016- Международная научно-техническая конференция «Фотоэлектроника и приборы ночного видения», Москва, Россия.

2006- Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники», Таганрог, Россия. 2013-Седьмая международная научно-техническая конференция «Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе».

МЭПП.Сумгаит.

2015 - Международная конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». Ташкент.

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

1. Investigation of electrodeposited p-Si/Cd_{1-x}Zn_xS_{1-y}Se_y heterojunction solar cells. Thin Solid Films, v.511-512, p.140-142, 2006.
2. Электрические и фотоэлектрические свойства солнечных элементов SnO₂/Cd_{0.4}Zn_{0.6}S/CdTe изготовленных электрохимическим методом. Физика и техника полупроводников, Санкт Петербург, 2013, т.40, в.12, стр.1476-1478,2006.
3. Фотоэлектрические свойства гетеропереходов n-Si/n-Cd_{1-x}Zn_xS, полученных методом электрохимического осаждения (на английском языке) // Thin Solid Films, 2005, V.480-481, p.388-391.
4. Температурная зависимость подвижности носителей заряда в чистых и легированных гадoliniем кристаллах GaSe . Неорганические материалы, 2012, т.48, в.6, с.649-653
5. Влияние температуры и легирования редкоземельными элементами на подвижность носителей заряда в кристаллах моноселенида индия. Физика и техника полупроводников, Санкт Петербург, 2013, том 47, вып.8, ст.1009-1013
6. Влияние температуры и легирования редкоземельными элементами на электрофизические параметры кристаллов моноселенида галлия. Неорганические материалы. Москва. 2014, том 50, №4, с.362-367
7. Влияние света на подвижность свободных носителей заряда в кристаллах моноселенида индия. Физика и техника полупроводников, Санкт-Петербург. 2014, том 48, вып. 8. С. 1009-1013
8. Приемники ИК-излучения на основе моноселенида галлия. Прикладная физика, 2015, Москва. № 5. С. 67-71
9. К вопросу об электрофизических свойствах монокристаллов n-InSe. Физика и техника полупроводников, 2016, Санкт-Петербург. том 50, вып. 1. С. 35-38
10. Effect of Various External and Internal Factors on the Carrier Mobility in n-InSe // International Journal of Engineering and Science, vol.6, Issue 11, December 2016, pp.01-04